



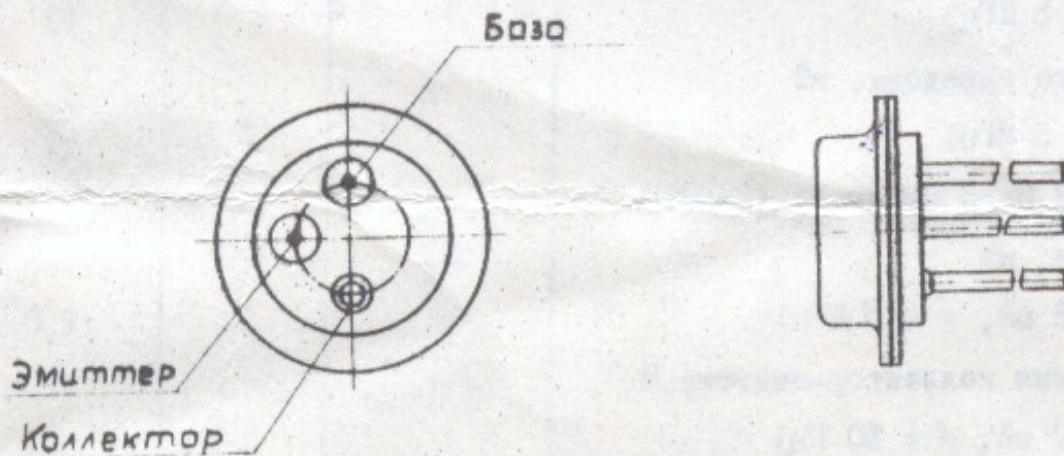
ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ
КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е,
КТ301Ж

КТ301Г
2,0

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы типов КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в радиотехнических и электронных устройствах.

Климатическое исполнение УХЛ3.



Масса не более 1 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ t окр. ср. = (+25 ± 10) °С

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения) тип транзистора	Буквенное обозначение	Н о р м а			
		2	3	4	не менее не более
Кoeffициент передачи тока в режиме малого сигнала ($U_{КБ} = 10В, I_{Э} = 3 мА, f = 1000 Гц$)	$h_{21э}$	10	32		
КТ301Г		20	60		
КТ301Д		40	120		
КТ301Е		80	300		
КТ301Ж			10		
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ} = 30 В$)	$I_{КЭ0}$				
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ} = 3 В$)	$I_{Э0}$				
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ} = 10В, I_{Э} = 3 мА, f = 20 МГц$)	$ h_{21э} $	1,5			
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{КБ} = 10В, f = 5 МГц$)	C_K			10	
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{ЭБ} = 0,5В, f = 5 МГц$)	$C_Э$			80	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, нс ($U_{КБ} = 10В, I_{Э} = 2 мА, f = 5 МГц$)	τ_K			2,0	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_B = 1 мА, I_K = 10 мА, f = 50 Гц$)	$U_{КЭнас}$			3	
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_B = 1 мА, I_K = 10 мА, f = 50 Гц$)	$U_{БЭнас}$			2,5	
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе, См ($U_{КБ} = 10В, I_{Э} = 3 мА, f = 1000 Гц$)	$h_{22б}$			3 · 10 ⁻⁶	

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов
в том числе: золото 0,00002424 г/мм на 3 выводах длиной 30 ± 2 мм.

золото - г.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж соответствуют техническим условиям АО.336.673 ТУ.

ШТАМП ОТК

Перепроверка произведена _____ дата

ШТАМП ОТК

ЛК 35

АВГ. 1990.